

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Том **44**, выпуск **20**, 26 октября **2018**



С.-Петербург
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

Содержание

К 100-летнему юбилею Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН	3
Георгиевский П.Ю., Левин В.А., Сутырин О.Г.	
Пространственные эффекты при взаимодействии ударной волны с продольным каналом газа пониженной плотности	5
Данченко Н.Г., Дубинов А.Е., Кожаева Ю.П.	
Измерение количества вещества, испаряемого с поверхности вязкой диэлектрической жидкости при наносекундном барьерном разряде	14
Хрусталёв А.П., Гаркушин Г.В., Жуков И.А., Разоренов С.В.	
Влияние структуры металломатричного композита магний-нитрид алюминия на его сопротивление деформированию при квазистатическом и динамическом нагружении	21
Дерябин А.С., Соколов Л.В., Труханов Е.М., Фрицлер К.Б.	
Достоверность выявления пронизывающих дислокаций в эпитаксиальных пленках с помощью структурно-чувствительного травления	30
Беляев М.А., Путролайнен В.В., Романенко В.А.	
Моделирование деформации многокристальных сборок NAND-памяти	37
Долгих Г.И.	
Лазерно-интерференционная система детектирования гравитационных волн .	46
Калмыков А.Е., Мясоедов А.В., Сорокин Л.М.	
Асимметрия дефектной структуры полуполярного GaN, выращенного на Si(001)	53
Орешкин В.И.	
Рост перегревных неустойчивостей в метастабильном металле	62

Шурыгина Н.А., Глазер А.М., Дьяконов Д.Л., Томчук А.А., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В.	
Влияние температуры деформации в камере Бриджмена на особенности формирования дефектной структуры технически чистого титана	70
Кузнецов В.В., Шамирзаев А.С.	
Влияние массовой скорости на величину критического теплового потока при кипении деионизованной воды с недогревом в микроканальной системе охлаждения	79
Черных А.В., Черных С.В., Диценко С.И., Буртебаев Н., Насурлла Маулен, Насурлла Маржан, Бритвич Г.И., Чубенко А.П., Барышников Ф.М., Слепцов Е.В.	
Арсенид-галлиевые детекторы с барьером Шоттки для спектрометрии альфа-частиц при температурах до 120°С	87
Черемисин А.Б., Кулдин Н.А.	
Коррелированное изменение электрических характеристик тонкопленочного полевого транзистора при модификации физических свойств его оксидного полупроводникового канала (InZnO:N)	95
Громов А.В., Гойхман М.Б., Ковалев Н.Ф., Палицин А.В., Fuks M.I., Schamiloglu E.	
Низкоэнергетическое состояние электронного пучка в коаксиальном диоде с однородным анодом и неоднородным профилем магнитного поля	102